

氮化镓 (GaN) 晶圆规格			
晶体生长方法	HVPE		
导电类型	半绝缘	N	N
类型/掺杂剂	Fe	Ge	Undoped
尺寸	10×10.5mm / 100.5 ± mm		
主定位边位置 / 长度	<1-100> ± 0.5° / 32.0 ± 1.0mm		
副定位边位置 / 长度	<11-20> ± 3° / 18.0 ± 1.0mm		
晶向	C 面 <0001>, 向 M 轴方向偏角 0.35°±0.15°		
电阻率(300k)	≥1E6 ohm-cm <0.05ohm.cm <0.5ohm.cm		
腐蚀坑密度	(1~9)E5/cm2,5E5~3E6/cm2,(1~3)E6/cm2		
表面粗糙度(nm)	正面表面粗糙度 Ra ≤0.2 nm		
TTV(um)	≤ 15		
Bow(um)	≤ 20		
Wrap(um)	≤ 20		
外延就绪	Yes		